

# SY 180/1 ... SY 180/14

## Silizium-Leistungsdiode im Metallgehäuse mit Gewindeanschluß M 8

Typ	$U_{RRM}^{1)}$ (V)	$U_{RSM}^{2)}$ (V)	$U_{RWM}$ (V)	$U_R$ (V)	$I_{F(AV)}^{3)}$ (A)	$I_{F(RMS)}$ (A)	$I_{FSM}^{4)}$ (A)
SY 180/1		100		70			
2		200		140			
4		400		280			
6		600		420			
8		800		560	30	47	420
10		1000		700			
12		1200		840			
14		1400		980			

- Sperrschichttemperatur  $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $150\text{ }^{\circ}\text{C}$

<sup>1)</sup>  $\frac{t_p}{T}$  (von  $U_R$ )  $\leq 0,5$ ;  $f = 50\text{ Hz} \dots 400\text{ Hz}$

<sup>2)</sup>  $t_p \leq 20\text{ ms}$       <sup>3)</sup> Sinushalbwellen,  $\theta_c = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

<sup>4)</sup> Sinushalbwellen,  $f = 40\text{ Hz} \dots 65\text{ Hz}$ ,  $\theta_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$

